



## VGF Ge n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Asドーパ (n型)	Gaドーパ (p型)
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ 6インチ	
面方位	(100)±0.5° (111)A, B±0.5°	

キャリア濃度	(cm <sup>-3</sup> )	N/A	N/A
抵抗率	(Ω.cm)	0.05~0.25	0.005~0.04
EPD (Ave)	(cm <sup>2</sup> )	≦300	≦300

直径	(mm)	50.8±0.3	76.2±0.3	100±0.3	150±0.3	—
厚さ	(μm)	175±25	175±25	175±25	225±25	—
TTV (両面研磨)	(μm)	≦15	≦15	≦15	≦15	—
Warp	(μm)	≦15	≦15	≦15	≦25	—
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	47.5±1.0	—

レーザーマーク	オプション					
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)				
	裏面	エッチド/鏡面研磨				
梱包形態	個別トレイ/カセット					



## CZ Ge n型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Sbドーパ (n型)	Unドーパ
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ	
面方位	(100)±0.5° (111)A, B±0.5°	

キャリア濃度	(cm <sup>-3</sup> )	N/A	N/A
抵抗率	(Ω.cm)	5~40	40~45
EPD (Ave)	(cm <sup>2</sup> )	N/A	N/A

直径	(mm)	50.0±0.5	76.0±0.5	100.0±0.5	—	—
		50.8±0.38	76.2±0.63	100.0±0.5	—	—
厚さ	(μm)	300~1,000				
OF長さ	(mm)	17.0±1.0	22.0±1.0	32.5±1.0	—	—

レーザーマーク	オプション					
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)				
	裏面	エッチド/鏡面研磨				
梱包形態	個別トレイ/カセット					

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。